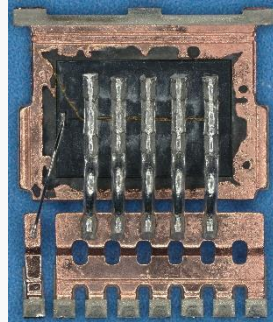


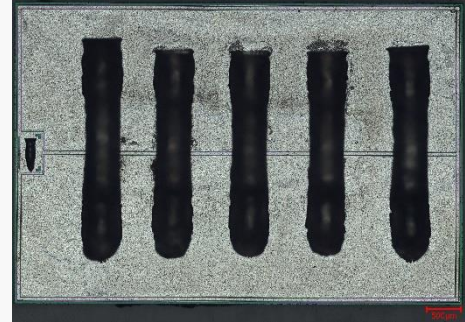
On Semiconductor製 Power MOSFET「NVBLS1DN08H」 構造解析レポート



製品外観



パッケージ内部構造



搭載チップ

概要

- ・On Semiconductor製Si-MOSFET
- ・ $V_{ds} = 80V$, $R_{ds(on)} = 1.05m\Omega$, $I_d = 351A(@25^\circ C)$, 最大動作温度 $175^\circ C$

製品特徴

- ・伝導損失を最小限に抑えるための低い $R_{ds(on)}$
- ・ドライバーの損失を最小限に抑えるための低いQGと静電気容量
- ・AEC-Q101(Automotive Electronics Council)認定及びPPAP (Production Part Approval Process)対応のデバイス
- ・スイッチングノイズ(EMI)を低減
- ・RoHSに順拠

解析のポイント

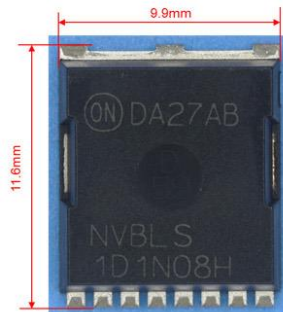
- ・Si-MOSFETの平面レイアウトおよび、断面構造(セル部、チップ端部)を明らかにしています。
- ・パッケージ構造解析では各部材の測長と材料の分析を行っています。

レポート内容と価格

OSi-MOSEFT 構造解析レポート: 60万円(税別)

構造解析レポートより抜粋

パッケージ外観

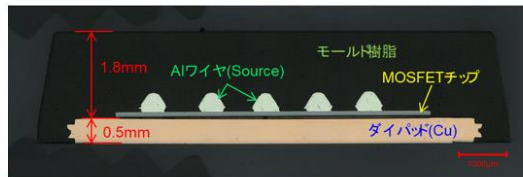


パッケージ外観



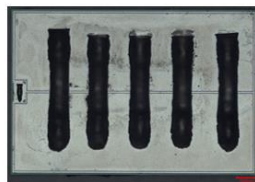
部分開封後

パッケージ断面



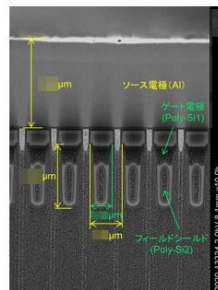
MOSFET外観

Die size: 4.40mm x 6.56mm = 28.86mm²



・トレンチ型ゲート、ソース上部メタル

セル部



外周部

